

单晶硅片

Monocrystalline Silicon Wafers

P型-G12



弘元新材料（包头）有限公司

地址：包头装备制造产业园区新规划区园区南路1号

网址：www.hoyuan.com

邮箱：sales@hoyuan.com

H SOLAR **G12-P**

材料特性

生长方式 Growing Method	CZ
掺杂剂/型号 Dopant/Model	Ga/P型
氧含量 Oxygen Content	$\leq 7.5 \times 10^{17}$ atoms/cm ³ (15ppma)
碳含量 Carbon Content	$\leq 5.0 \times 10^{16}$ atoms/cm ³ (1ppma)
位错密度 Dislocation Density	≤ 500 pcs/cm ²
晶向 Crystal Orientation	$\langle 100 \rangle \pm 2^\circ$

电学特性

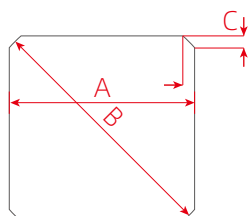
电阻率 Resistivity	0.4~1.1Ω.cm
少子寿命 Minority Carrier Lifetime	$\geq 80\mu\text{s}$

几何尺寸及表面性能

硅片型号 Wafer Model	G12
几何外形 Geometry	准方 Square
倒角边形状 Chamfered Edge Shape	直角 Right Angle
硅片边长 Wafer Side Length	210±0.25mm
硅片对角线 Wafer Diagonal	295±0.25mm
倒角尺寸-直角边 Chamfered Edge Length	1.41±0.45mm
倒角尺寸-弦长 Chord Length	1.99±0.7mm
直角度 Right Angle	90±0.15°
厚度 Thickness	±10μm
TTV Total Thickness Variation	≤25μm
线痕 Saw Marks	≤13μm
翘曲度 Warpage	≤40μm
切割方式 Slicing Method	金刚线切割 Diamond Wire Slicing

硅片尺寸示意图

Schematic Diagram Of Wafer Dimension



Size: G12

A: 210±0.25mm

B: 295±0.25mm

C: 1.41±0.45mm